

Title	Thermoelectric properties of InSb- and CoSb_3-based compounds
Author(s)	Kim, Donghun
Citation	
Issue Date	
Text Version	ETD
URL	https://doi.org/10.18910/26171
DOI	10.18910/26171
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University

論文内容の要旨

[題 名] Thermoelectric properties of InSb- and CoSb₃-based compounds(InSb及びCoSb₃基化合物の熱電特性)

学位申請者 金 東勲 (DONGHUN KIM)

In this thesis, the thermoelectric (TE) properties of InSb- and $CoSb_3$ -based compounds were studied, with the goal of developing high performance TE materials. This thesis is composed of five chapters. In the first chapter, the basic science, engineering, and theory of TEs were explained. InSb and $CoSb_3$ are candidates of high-performance TE materials owing to their high mobility and semiconductor behavior. However, these compounds have high thermal conductivity (κ), so the TE figure of merit (ZT) is not so high. To enhance the ZT, the author tried to reduce the κ of InSb and $CoSb_3$.

In the second chapter, the experimental details of the characterizations method for TE research were explained.

In the third chapter, the author tried to reduce the κ of InSb by the isoelectronic and isostructural solid solution of InSb. The TE properties of InSb-Zn λ Sb₂ (λ = Si, Ge, Sn, or Pb) and InSb-In₂ λ Te (λ = Si, Ge, or Sn) solid solutions were studied. The InSb-Zn λ Sb₂ (λ = Si, Ge, Sn, or Pb) solid solutions were identified having the zincblende structure. The InSb-Zn λ Sb₂ system exhibited a ρ -type and metallic behavior, unlike InSb typically shows κ -type and semiconductor behavior. In this system, the Zn doping could reduce the κ of InSb owing to effective point-defect phonon scattering. In view of the possibility of cross-substitution in the anionic sub-lattice, an attempt was made to prepare and characterize the InSb-In₂ λ Te (λ = Si, Ge, or Sn) system. InSb-In₂GeTe sample exhibited larger absolute λ values than those of InSb-In₂SiTe and InSb-In₂SnTe. In this system, although the thermal conductivities were reduced through the point-defect phonon scattering, the λ T values were comparable to that of InSb.

In the fourth chapter, the author tried to reduce the κ of $CoSb_3$ by Tl-filling and replacement of Fe with Co. Polycrystalline samples of $Tl_xFe_1Co_3Sb_{12}$ (x=0, 0.2, 0.4, 0.6, and 0.8) were prepared and their TE properties were examined at high temperature. The filling fraction limit of Tl in $Tl_xFe_1Co_3Sb_{12}$ was between x=0.4 and 0.6. All samples exhibited positive S values. Tl-adding decreased the hole concentration because Tl acted as a dopant. Not only the rattling by the Tl-filling but also the partial replacement of Fe with Co scattered phonons effectively, leading to significant reduction of κ . The maximum ZT was 0.36 at 723 K obtained for $Tl_{0.2}Fe_1Co_3Sb_{12}$.

In the last chapter, the obtained results were summarized and suggestions for future works were proposed.

論文審査の結果の要旨及び担当者

氏	名	(金	東 勲)
		(職)	氏	名
	主査	教授	中山	伸介
論文審查担当者	副査	教授	山本	孝夫
	副査	准教授	西川	宏 1
	副査	准教授	黒﨑	健

論文審査の結果の要旨

本論文では、高性能熱電材料を開発することを目的として、InSb 及び CoSb₃ 基化合物の熱電特性が研究されている。 本論文は、以下の五章から構成されている。

第一章では、導入部として、熱電材料に関する基礎的な科学と理論が述べられている。InSb と $CoSb_3$ は高いキャリア移動度と半導体的な特性をもっているため、高性能熱電材料として注目されている。一方、InSb と $CoSb_3$ は高い熱伝導率を有していることから、高い熱電変換性能指数 (ZT) を示すことはできい。そこで、高い ZT を達成するため、InSb と $CoSb_3$ の熱伝導率の低減を目指して研究が行われた。

第四章では、スクッテルダイト型の結晶構造を有する $CoSb_3$ に T1 を充填すると共に Co サイトに Fe を置換することで、p 型スクッテルダイト化合物が作製され、その熱電特性が評価されている。Co と Fe の比を固定したうえで T1 量を変化させることで、熱電特性を最大化するための組成の最適化が行われている。具体的には、 $T1_*Fe_1Co_3Sb_{12}$ (x=0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8)を溶融法で作製し、各種熱電特性の T1 量依存性が評価されている。T1 の充填限界量は、x=0.5 程度である旨が報告されている。T1 の充填量が増大するにつれてキャリア濃度が低減する結果が得られている。充填された T1 がラットリングすることでフォノンを効果的に散乱することに加えて、Co サイトへの Fe 置換もフォノン散乱に寄与したことから、熱伝導率が大幅に低減され、結果 ZT が増大することが示されている。

第五章はまとめであり、本研究で得られた成果が要約されている。

以上のように、本論文は環境・エネルギー工学、特にエネルギーの有効利用技術としての熱電発電技術の開発に寄 与するところが大きい。

よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。